

1	introduction	<i>introduction</i>
4	composants pour l'espace	<i>space components</i>
5	diodes hyperfréquence	<i>microwave diodes</i>
8	varactors	<i>varactors</i>
11	diodes de contrôle	<i>control diodes</i>
17	diodes de réception	<i>receiver diodes</i>
20	diodes d'émission	<i>emission diodes</i>
23	transistors bipolaires	<i>bipolar transistors</i>
29	transistors à effet de champ	<i>field effect transistors</i>
35	fonctions microonde	<i>microwave functions</i>
37	oscillateurs	<i>oscillators</i>
39	amplificateurs	<i>amplifiers</i>
40	modules microonde	<i>microwave modules</i>
47	modules TO 8	<i>TO 8 modules</i>
49	composants optiques	<i>optical components</i>
55	lignes à retard	<i>delay lines</i>
59	composants à ferrite	<i>ferrite components</i>
61	dispositifs coaxiaux	<i>coaxial devices</i>
67	dispositifs sur guide	<i>waveguide devices</i>
70	dispositifs de puissance	<i>power devices</i>
73	dispositifs divers	<i>miscellaneous devices</i>
77	matériaux ferrite	<i>ferrite material</i>
79	boîtiers	<i>packages</i>
85	index	<i>index</i>
89	adresses	<i>addresses</i>

Une diode est formée soit d'une jonction entre 2 zones de matériaux semiconducteurs de polarité opposée, soit d'un contact ou d'une jonction métal semiconducteur. La famille des diodes se subdivise en sous-familles de structures, de caractéristiques et d'utilisations très différentes :

Les varactors sont classés en :

- varactors générateurs d'harmonique utilisés pour la multiplication de fréquence,
- varactors paramétriques, utilisés dans les amplificateurs paramétriques,
- varactors limiteurs,
- varactors transposeurs de fréquence utilisés en mélange et en modulation paramétrique.

Les diodes de contrôle comprennent les :

- diodes PIN : commutateurs rapides et atténuateurs à résistance variable,
- diodes Schottky : commutateurs à grande vitesse,
- diodes "snap-off" : commutateurs très rapides,
- diodes varicaps : capacités variables pour l'accord de circuits.

Les diodes de réception se décomposent en :

- cristaux détecteurs et mélangeurs,
- diodes Schottky détectrices et mélangeuses.

Les diodes d'émission comprennent les :

- diodes Gunn pour oscillateurs à faible bruit,
- diodes à avalanche pour oscillateurs de puissance.

A diode is formed, either by junction of two areas of oppositely polarised semiconductor material in contact or by a semiconductor metal junction. The family of diodes is sub-divided into groups of structures, of very different characteristics and uses:

Varactors are classed as:

- *harmonic generator varactors for frequency multiplication,*
- *parametric varactors, used in parametric amplifiers,*
- *limiter varactors,*
- *frequency transposer varactors used in mixers and parametric modulation.*

Control diodes include:

- *PIN diodes: fast switches and variable resistance attenuators,*
- *Schottky diodes: ultra-fast switching,*
- *"step recovery" diodes: very fast switching,*
- *varicap diodes: variable capacitance for tuning circuits.*

Receiver diodes are available as:

- *crystal detectors and mixers,*
- *Schottky mixers and detectors.*

Emission diodes include:

- *Gunn diodes for low noise oscillators,*
- *Impatt diodes for power oscillators.*

symboles

TENSIONS		VOLTAGES
V_F	TENSION DIRECTE CONTINUE	FORWARD DIRECT VOLTAGE
V_R	TENSION INVERSE CONTINUE	REVERSE DIRECT VOLTAGE
V_{BR}	TENSION DE CLAQUAGE	BREAKDOWN VOLTAGE
V_N	LA COURBE C (V) (ÉCHELLE LOG-LOG) PRÉSENTE UN POINT D'INFLEXION POUR $V = V_N$ (DIODES D'ACCORD)	THE CURVE C (V) (LOG-LOG SCALE) HAS AN INFLEXION POINT AT $V = V_N$ (TUNING DIODES)
COURANTS		CURRENTS
I_F	COURANT DIRECT CONTINU	FORWARD DIRECT CURRENT
I_R	COURANT INVERSE CONTINU	REVERSE DIRECT CURRENT
PUISSANCE		POWER
P_E	PUISSANCE EN ENTRÉE	INPUT POWER
P_O	PUISSANCE EN SORTIE	OUTPUT POWER
$P_{diss.}$	PUISSANCE DISSIPÉE	POWER DISSIPATION
P_{rfmax}	PUISSANCE RF MAXIMUM ADMISSIBLE	MAXIMUM RF POWER
$P_{L.O.}$	PUISSANCE DE L'OSCILLATEUR LOCAL	LOCAL OSCILLATOR POWER
PARAMÈTRES DE COMMUTATION		SWITCHING PARAMETERS
τ_L	DURÉE DE VIE DES PORTEURS MINORITAIRES	MINORITY CARRIER LIFETIME
t_{so}	TEMPS DE RETOUR RAPIDE	SNAP-OFF TIME
t_{cr}	TEMPS DE COMMUTATION INVERSE	REVERSE SWITCHING TIME
GRANDEURS DIVERSES		ADDITIONAL ITEMS
r_{SF}	RÉSISTANCE SÉRIE DANS LE SENS DIRECT	FORWARD SERIE RESISTANCE
r_{SR}	RÉSISTANCE SÉRIE DANS LE SENS INVERSE	REVERSE SERIES RESISTANCE
R_V	RÉSISTANCE VIDÉO	VIDEO RESISTANCE
R_{th}	RÉSISTANCE THERMIQUE	THERMAL RESISTANCE
C_j	CAPACITÉ DE JONCTION	JUNCTION CAPACITANCE
C_T	CAPACITÉ TOTALE	TOTAL CAPACITANCE
C_{T1} C_{T2}	RAPPORT DES CAPACITÉS TOTALES POUR LES TENSIONS V_1 ET V_2	TUNING RATIO FOR TWO-REVERSE VOLTAGES V_1, V_2
Q	FACTEUR DE QUALITÉ	QUALITY FACTOR
α_c	COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DES DIODES A CAPACITÉ VARIABLE	TEMPERATURE COEFFICIENT OF CAPACITANCE
γ	PENTE DE LA COURBE C (V) POUR $V = V_N$	SLOPE OF THE CURVE C (V) AT $V = V_N$
f_c	FRÉQUENCE DE COUPURE	CUT-OFF FREQUENCY
f_{c-6}	FRÉQUENCE DE COUPURE ($V = -6$ V)	CUT-OFF FREQUENCY ($V = -6$ V)
f_E	FRÉQUENCE D'ENTRÉE	INPUT FREQUENCY
f_O	FRÉQUENCE DE SORTIE	OUTPUT FREQUENCY
T_{ss}	SENSIBILITÉ TANGENTIELLE	TANGENTIAL SENSITIVITY
R.O.S. V.S.W.R.	RAPPORT D'ONDE STATIONNAIRE	STANDING WAVE RATIO
NF_o	FACTEUR DE BRUIT EN SIMPLE BANDE	SSB NOISE FIGURE
f	FRÉQUENCE	FREQUENCY
Z_{if}	IMPÉDANCE A LA FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE	INTERMEDIATE FREQUENCY IMPEDANCE
M	COEFFICIENT DE MÉRITE	FIGURE OF MERIT
R_A	RÉSISTANCE ÉQUIVALENTE DE BRUIT DE L'AMPLIFICATEUR VIDÉO	RESISTANCE REPRESENTING THE AMPLIFIERS NOISE CONTRIBUTION
R_L	RÉSISTANCE DE CHARGE	LOAD RESISTANCE

varactors varactors



varactors multiplicateurs à l'arséniure de gallium gallium arsenide multiplier varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS				$I_R = 10 \mu A$	$V_R = 3 V$	$V = 0 V$ $f = 1 MHz$	$f_E = 10 GHz$	$f_O = 3 f_E$	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS		
CARACTERISTIQUES A SPECIFICATIONS AT				$T = 25 ^\circ C$	V_{BR}	I_R	C_j	C_j	P_E	P_O	TEMPERATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$
TYPE TYPE	BOITIER CASE	Nbre DE VARACTORS Nber OF VARACTORS	FRÉQUENCE FREQUENCY GHz	V min	μA max	pF min	pF max	mW max	mW min	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
AH 131	F 27 d		30-40	10	0.1	0.2	0.5	100	15	-40 + 70	-65 + 175
AH 132	F 27 d		30-40	10	0.1	0.2	0.5	100	25		
AH 133	F 27 d		30-40	15	0.1	0.2	0.5	150	40		
AH 134	F 27 d		30-40	15	0.1	0.2	0.5	350	100		
AH 135	F 27 d		30-40	20	0.1	0.3	0.7	500	150		
AH 141	E 4 p	2	30-40	30	0.1	0.2	0.4	0.8	200	-40 + 70	-65 + 175
AH 142	E 5 p	3	30-40	45	0.1	0.15	0.3	1.2	300		

varactors multiplicateurs au silicium silicon multiplier varactors

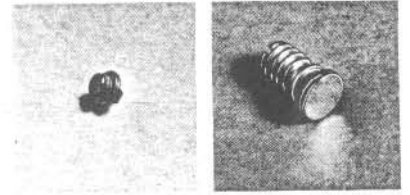
CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS				$I_R = 10 \mu A$	$V_R = -6 V$ $f = 1 MHz$	$+10 mA$ $-6 mA$	$+10 mA$ $-10 V$	$f_O = 3 f_E$	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS				
CARACTERISTIQUES A SPECIFICATIONS AT				$T = 25 ^\circ C$	V_{BR}	C_j	T_e	t_{SO}	R_{th}	P_O	TEMPERATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$		
TYPE TYPE	BOITIER CASE	Nbre DE VARACTORS Nber OF VARACTORS	FRÉQUENCE FREQUENCY GHz	V min	V max	pF min	pF max	ns min	ps max	$^\circ C/W$ max	W	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 238 G	F 49 p	2	2-4	120	160	3	5	200	400	10	14	-65 + 175	-65 + 200
DH 239 G	F 49 p	2	3-5	90	130	2	4	150	200	12	10		
DH 240 G	F 49 p	2	2-6	80	120	1.4	2.4	150	200	17	6		
DH 241 G	F 27 d	2	4-8	70	110	0.9	1.4	60	150	20	4		
DH 242 G	F 27 d	2	8-12	60	90	0.4	0.6	30	100	25	1.7		
DH 243 G	F 27 d	2	12-18	50	70	0.2	0.4	20	80	40	0.6		
DH 236	E 2 p	2	1-3	160	220	4	6	400	600	6	20		
DH 240	E 1 p	2	4-6	80	120	1.4	2.4	150	200	17	6		
DH 241	E 1 p	2	4-8	70	110	0.9	1.4	60	150	20	4		
DH 242	E 1 p	2	8-12	60	90	0.4	0.6	30	100	25	1.7		
DH 243	E 1 p	2	12-18	50	70	0.2	0.4	20	80	40	0.6		
DH 245	E 3 p	3	9-14	90	120	0.4	0.6	30	100	25	3		
DH 246	E 3 p	3	12-18	70	100	0.25	0.4	20	80	35	1.2		
DH 286	E 2 p	4	2-6	180	280	0.9	1.3	150	200	6	25 (d)		
DH 287	E 1 p	4	6-12	120	180	0.4	0.7	60	150	13	8 (d)		
DH 288	E 1 p	4	12-18	90	140	0.2	0.4	30	80	25	3 (d)		
DH 294	DO 7	1	0.2-2	45	70	6	10	125	400	300	0.5 (d)		
DH 200	F 49	1	0.5-2	90	140	5.5	7	250	1000	8	20 (d)		
DH 270	S 268	1	2-3	80	110	4	5.5	160	700	10	15 (d)		
DH 110	F 27 d	1	2-4	60	90	3	4	100	400	25	9 (d)		
DH 293	F 60 d	1	3-6	50	70	2	3	60	250	30	6 (d)		
DH 252	F 27 d	1	2-8	40	60	0.9	2	35	200	50	3 (d)		
DH 256	F 27 d	1	5-12	30	45	0.5	1.1	20	120	60	2 (d)		
DH 292	F 27 d	1	8-16	20	35	0.2	0.5	10	75	70	0.6 (d)		
DH 267	F 27 d	1	10-25	15	25	0.2	0.3	6	60	100	0.2 (d)		

(d) En doubleur

(d) Doubleur test

varactors multiplicateurs et de commutation au silicium, en microéléments silicon multiplier and switching varactors, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			10 mA -6 mA	+10 mA -10 V	$I_R = 10 \mu A$	$V_R = 6 V$ $f = 1 MHz$	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS	
CARACTERISTIQUES A SPECIFICATIONS AT			$T = 25 ^\circ C$	T_L	t_{SO}	V_{BR}	C_j	TEMPERATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ns typ	ps typ	V min	pF min	pF max	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 255	C 2	40	120	40	0.8	1.4	-65 + 175	-65 + 200
EH 256	C 2	20	90	30	0.5	0.8		
EH 257	C 2	15	80	25	0.3	0.5		
EH 258	C 2	10	70	20	0.15	0.3		



varactors paramétriques à l'arséniure de gallium gallium arsenide parametric varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = 6\text{ V}$	$I_R = 10\ \mu\text{A}$	$V_R = 3\text{ V}$	$V = 0\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$V_{R1} = 0\text{ V}$ $V_{R2} = 6\text{ V}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25\text{ °C}$	f_c	V_{BR}	I_R	C_1	C_2	$\frac{C_{11} - C_{12}}{C_{11}}$	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C
TYPE TYPE	BOITIER CASE	GHz min	V min	μA max	pF min	pF max	min	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
AH 106	F 54	600	6	1	0,2	0,3	0,45	- 65 + 70	- 65 + 150
AH 108	F 54	600	6	1	0,3	0,4	0,5		
AH 110	F 54	1000	6	1	0,2	0,3	0,5		

varactors paramétriques au silicium silicon parametric varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$I_R = 10\ \mu\text{A}$	$V_R = 0\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$V_R = 0\text{ V}$ $f = 2,75\text{ GHz}$	$V_R = -6\text{ V}$ $f = 2,75\text{ GHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25\text{ °C}$	V_{BR}	C_1	C_2	f_{co}	f_{c-e}	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOITIER CASE	FREQUENCE FREQUENCY GHz	V min	pF min	pF max	GHz	GHz	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 751	F 27 d	1-2	6	0,9	1,1	50	125	- 55 + 150	- 65 + 200
DH 752	F 27 d	2-4	6	0,5	0,7	70	150		
DH 753	F 27 d	4-8	12	0,2	0,3	100	200		
DH 755	F 27 d	4-8	12	0,3	0,5	100	200		
DH 756	F 27 d	8-12	12	0,1	0,2	250	500		

varactors limiteurs au silicium silicon limiter varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$I_R = 10\ \mu\text{A}$	$V_R = 6\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$V_R = 6\text{ V}$ $f = 2,75\text{ GHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS						
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25\text{ °C}$	V_{BR}	V_{BR}	C_1	C_2	f_c	R_{th}	$P_{diss.}$	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOITIER CASE	FREQUENCE FREQUENCY GHz	V min	V max	pF min	pF max	GHz min	°C/W max	W max	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 601	F 27 d	6	30	45	0,2	0,5	150	90	0,75	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 602	F 27 d	6	30	45	0,2	0,5	200	90	0,75		
DH 603	F 27 d	8	60	90	0,2	0,5	80	70	1		
DH 604	F 27 d	8	60	90	0,2	0,5	150	70	1		
DH 605	F 27 d	10	90	120	0,2	0,5	100	50	1,5		
DH 606	F 27 d	12	120	150	0,2	0,5	100	40	2		

varactors limiteurs au silicium en microéléments silicon limiter varactors, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$I_R = 10\ \mu\text{A}$	$V_R = 0\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$V_R = 0\text{ V}$ $f = 2,75\text{ GHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25\text{ °C}$	V_{BR}	C_1	C_2	f_c	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C
TYPE TYPE	PRESENTATION PRESENTATION	V min	pF min	pF max	GHz min	FONCTION OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 624	C 2	25	0,2	0,3	140	- 55 + 150	- 65 + 175
EH 625	C 2	25	0,1	0,2	180		

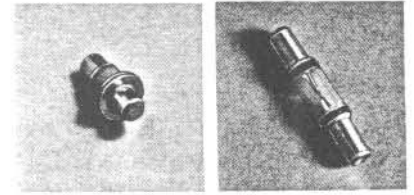
varactors

varactors

varactors transposeurs de fréquence au silicium silicon up-conversion varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$I_R = 10 \mu A$	$V_R = -6 V$ $f = 1 MHz$			$V_R = -6 V$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ C$	V_{BR}	C_j	C_j	f_c	PERTES CONVERSION LOSSES	$P_{diss.}$	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOITIER CASE	FRÉQUENCE FREQUENCY GHz	V min	pF min	pF max	GHz min	dB	W	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 631	F 27 d	1	90	5	7.5	35	3	5		
DH 631 B	F 49	1	90	5	7.5	35	3	7		
DH 632	F 27 d	2	90	3	5	50	3.4	5		
DH 632 B	F 49	2	90	3	5	50	3	7		
DH 633	F 27 d	4	70	1.5	2.5	80	3.5	2.5		
DH 633 B	F 49	4	70	1.5	2.5	80	3.5	3.5		
DH 634	F 27 d	6	50	0.8	1.2	140	4	1.5	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 634 B	F 49	6	50	0.8	1.2	140	4	2		
DH 635	F 27 d	8	40	0.7	0.9	180	4	1		
DH 635 B	F 49	8	40	0.7	0.9	180	4	1.5		
DH 636	F 27 d	10	40	0.6	0.8	200	4.5	1		
DH 637	F 27 d	13	25	0.4	0.6	250	5.4	1		

diodes de contrôle control diodes



diodes PIN de commutation rapide fast switching PIN diodes

CONDITIONS DE MESURES MEASURING CONDITIONS		20 mA - 10 V/50 Ω	$I_F = 100 \text{ mA}$	$I_R = 10 \text{ } \mu\text{A}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	t_{cr}	r_{SF}	V_{BR}	C_T	R_{th}	TEMPÉRATURES $^\circ\text{C}$ TEMPERATURES $^\circ\text{C}$
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	ns typ	max	V min	pF max	$^\circ\text{C/W}$ max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 401	F 27 d	15	1	100	0.4	60		
DH 401 B	A 22 e	15	1	100	0.3			
DH 402	F 27 d	25	1	150	0.4	50		
DH 402 B	A 22 e	25	1	150	0.3			
DH 405	F 27 d	15	1.2	150	0.3	70		
DH 405 B	A 22 e	15	1.2	150	0.2			
DH 403	F 27 d	50	1	200	0.4	40	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 403 B	A 22 e	50	1	200	0.3			
DH 404	F 27 d	70	1.5	250	0.28	40		
DH 407	F 27 d	70	1.2	250	0.36	35		
DH 408	F 27 d	70	1	250	0.4	30		
DH 409	F 27 d	70	0.8	250	0.45	25		

diodes PIN de commutation ultra-rapide ultra-fast switching PIN diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		20 mA - 10V/50 Ω	$I_F = 20 \text{ mA}$	$I_R = 10 \text{ } \mu\text{A}$	$V_R = 6 \text{ V}$	$C_T = 0 \text{ V}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	t_{cr}	r_{SF}	V_{BR}	C_T	R_{th}	TEMPÉRATURE $^\circ\text{C}$ TEMPERATURES $^\circ\text{C}$	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	ns typ	max	V min	pF max	pF max	$^\circ\text{C/W}$ max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 531	F 27 d	4	1.2	50	0.6	0.8	60		
DH 531 B	A 22 e	4	1.2	50	0.4	0.6			
DH 532	F 27 d	6	1	70	0.6	0.8	60	- 55 + 150	- 65 + 200
DH 532 B	A 22 e	6	1	70	0.4	0.6			

diodes PIN de commutation et de déphasage (moyenne et forte puissance) switching and phase shifting PIN diodes (medium and high power)

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		20 mA - 10 V/50 Ω	10 mA - 6 mA	$V_R = 50 \text{ V}$	$I_F = 100 \text{ mA}$	$I_R = 10 \text{ mA}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	t_{cr}	τ_L	r_{SR}	r_{SF}	V_{BR}	C_T	R_{th}	TEMPÉRATURES $^\circ\text{C}$ TEMPERATURES $^\circ\text{C}$	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	ns typ	μs typ	Ω max	Ω max	V min	pF min	pF max	$^\circ\text{C/W}$ max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 441	F 27 d	150	1	1	1	500	0.35	0.45	15		
DH 442	F 27 d	200	1	1	1	500	0.27	0.33	20		
DH 443	F 27 d	200	2	1	0.7	500	0.35	0.45	15		
DH 438	F 27 d	250	2	1	0.5	500	0.5	0.7	15		
DH 437	DO 7	250	2	1	0.5	500	0.4	0.6	100		
DH 439	F 27 d	250	2	1	0.5	700	0.5	0.7	15	- 55 + 150	- 65 + 200
DH 451	F 27 d	300	2	1.5	1.5	900	0.27	0.33	15		
DH 453	F 27 d	300	3	1	0.6	900	0.4	0.6	15		
DH 454	F 27 d	350	5	1	0.6	1200	0.5	0.7	15		
DH 482	F 27 SA	500	7	1	0.8	1800	0.8	1	15		

diodes de commutation de puissance rapides high speed power switching diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		20 mA - 10V/50 Ω	$I_R = 10 \text{ } \mu\text{A}$	$V_R = 30 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$I_F = 20 \text{ mA}$	$I_F = 20 \text{ mA}$	$V_R = - 10 \text{ V}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	FREQUENCE FREQUENCY	t_{cr}	$P_{diss.}$	V_{BR}	C_T	r_{SF}	PERTES Insertion losses	DÉCOUPL. ISOLATION	TEMPÉRATURES $^\circ\text{C}$ TEMPERATURES $^\circ\text{C}$
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	GHz	ns type	W	V min	pF typ	Ω typ	dB typ	dB typ	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 582	F 32 b	10	8	0.6	80	0.14	1.5	0.5	30		
DH 583	F 32 b	12	6	0.5	80	0.12	2	0.5	30		
DH 584	F 32 b	15	5	0.4	80	0.105	2.5	0.5	30	- 25 + 70	- 40 + 100
DH 585	F 32 b	18	4	0.4	80	0.095	3	0.5	30		

diodes de contrôle control diodes

diodes PIN pour atténuation attenuating PIN diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			$I_F = 0.1 \text{ mA}$	$I_F = 1 \text{ mA}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$V_R = 100 \text{ V}$	10 mA $- 6 \text{ mA}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS					
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ °C}$	r_{SF}		r_{SF}		C_t	I_R	τ_L	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C				
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	EPAISSEUR ZONE I THICKNESS μm	Ω min	Ω max	Ω min	Ω max	Ω min	Ω max	pF min	pF max	μA max	μs typ	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 488	F 27 d	70	70	140	8	16	1	2	0.5	0.7	10	2		
DH 489	F 27 d	100	120	240	15	30	2.1	4.2	0.4	0.6	10	3		
DH 491	DO 7	140	120	240	15	30	2.1	4.2	0.3	0.7	10	5		
DH 493	A 22 e	140	200	400	25	50	3.5	7	0.2	0.4	10	4	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 495	F 27 d	140	120	240	15	30	2.1	4.2	0.4	0.8	10	5		
DH 496	F 27 d	200	400	800	50	100	6.5	13	0.3	0.5	10	7		

diodes PIN de commutation rapide, en microéléments fast switching PIN diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			20 mA $- 10 \text{ V}/50 \text{ }\Omega$	$I_F = 100 \text{ mA}$	$I_R = 10 \text{ }\mu\text{A}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ °C}$	t_{cr}	r_{SF}	V_{BR}	C_j	C_j	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ns typ	Ω	V min	pF min	pF max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE	
EH 404	C2	70	1.5	200	0.04	0.08			
EH 407	C2	70	1.2	200	0.08	0.16			
EH 408	C2	70	1	200	0.16	0.2	- 55 + 150	- 65 + 175	
EH 409	C2	70	0.8	200	0.2	0.25			

diodes PIN de commutation et de déphasage, (moyenne et forte puissance), en microéléments switching and phase shifting PIN diodes (medium and high power), microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			20 mA $- 10/50 \text{ }\Omega$	10 mA $- 6 \text{ mA}$	$V_R = 50 \text{ V}$	$I_F = 100 \text{ mA}$	$I_R = 10 \text{ }\mu\text{A}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ °C}$	t_{cr}	τ_L	r_{SR}	r_{SF}	V_{BR}	C_j	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ns typ	μs typ	Ω max	Ω max	V min	pF min	pF max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 424	C2	150	1	1	1	500	0.15	0.25		
EH 426	C2	250	2	1	0.5	700	0.30	0.50		
EH 428	C2	300	2	1.5	1.5	900	0.08	0.15	- 55 + 150	- 65 + 200
EH 429	C2	300	3	1	0.6	900	0.2	0.4		

diodes PIN pour atténuation, en microéléments attenuating PIN diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			$I_F = 0.1 \text{ mA}$	$I_F = 1 \text{ mA}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	$V_R = 50 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$V_R = 100 \text{ V}$	10 mA $- 6 \text{ mA}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS					
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 \text{ °C}$	r_{SF}		r_{SF}		C_j	I_r	τ_L	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C				
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	EPAISSEUR ZONE I THICKNESS μm	Ω min	Ω max	Ω min	Ω max	Ω min	Ω max	pF min	pF max	μA max	μs typ	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 488	C4	70	70	140	8	16	1	2	0.3	0.5	10	2		
EH 491	C4	100	120	240	15	30	2.1	4.2	0.2	0.35	10	3		
EH 493	C4	140	200	400	25	50	3.5	7	0.15	0.30	10	4	- 55 + 150	- 65 + 175
EH 496	C4	200	400	800	50	100	6.5	13	0.1	0.2	10	7		



diodes PIN de commutation rapide en beam-lead fast switching beam-lead PIN diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		10 mA -10 V/50 Ω	$I_F = 50$ mA	$I_R = 10$ μA	$V_R \begin{cases} -50$ V -10 V $f = 1$ MHz	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25$ °C	t_{cr}	r_{SF}	V_{BR}	C_T	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ns typ	Ω	V min	pF max	FONCTION. OPERATING		STOCKAGE STORAGE
EH 412	C101	100	3.5	200	0.03	-55 + 150	-65 + 175	
EH 533	C100	5	3.5	40	0.03			

diodes snap-off step recovery diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		+10 mA -6 mA	+10 mA -10 V		$I_R = 10$ mA	$V_R = 6$ V $f = 1$ MHz	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25$ °C	τ_L	t_{so}	P_{diss}	V_{BR}	C_j	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	ns min	ps typ	ps max	W max	V min	pF max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 541	A 22 e	25	90	140	0.25	30	1.5		
DH 542	A 22 e	40	150	250	0.25	50	1.5	-55 + 175	-65 + 200
DH 543	A 22 e	20	90	140	0.25	30	1		
DH 544	A 22 e	35	150	250	0.25	50	1		
DH 551	F 27 d	15	70	100	1	20	1		
DH 552	F 27 d	20	90	140	1	30	1	-55 + 175	-65 + 200
DH 553	F 27 d	30	120	250	1	40	1		

varicaps abrupts au silicium silicon abrupt tuning diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = 4$ V $f = 1$ MHz	$V_1 = 2$ V $V_2 = 30$ V $f = 1$ MHz	$V_R = 4$ V $f = 50$ MHz	$I_R = 10$ μA	$V_R = 25$ V	$V_R = -4$ V $f = 1$ MHz $T \begin{cases} -65$ °C +85 °C	CONDITIONS LIMITEES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25$ °C	$C_T \pm 10\%$	C_{T1}/C_{T2}	Q	V_{BR}	I_R	α_C	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	pF	pF min		min	V min	μA max	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 7811 A	DO 7	6.8	2.7	800	30	0.02	0.02	400		
DH 7812 A	DO 7	8.2	2.8	800	30	0.02	0.02	400		
DH 7813 A	DO 7	10	2.8	750	30	0.02	0.02	400		
DH 7814 A	DO 7	12	2.8	750	30	0.02	0.02	400		
DH 7815 A	DO 7	15	2.8	750	30	0.02	0.02	400		
DH 7816 A	DO 7	18	2.8	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7817 A	DO 7	20	2.8	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7818 A	DO 7	22	2.9	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7819 A	DO 7	27	2.9	700	30	0.02	0.02	400	-55 + 100	-65 + 150
DH 7820 A	DO 7	33	2.9	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7821 A	DO 7	39	2.9	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7822 A	DO 7	47	2.9	700	30	0.02	0.02	400		
DH 7823 A	DO 7	56	2.9	500	30	0.02	0.02	400		
DH 7824 A	DO 7	68	2.9	500	30	0.02	0.02	400		
DH 7825 A	DO 7	82	2.9	300	30	0.02	0.02	400		
DH 7826 A	DO 7	100	2.9	300	30	0.02	0.02	400		
DH 740	F 27 d	0.8	2.4	140	40					
DH 741	F 27 d	1.2	2.8	135	40					
DH 742	F 27 d	1.8	3	130	40					
DH 743	F 27 d	2.7	3.2	120	40				-55 + 150	-65 + 200
DH 744	F 27 d	3.9	3.4	110	40					
DH 745	F 27 d	4.7	3.9	100	40					
DH 746	F 27 d	5.6	3.6	95	40					
DH 747	F 27 d	6.8	3.7	90	40					
DH 790	F 27 d	0.8	1.8	195	25					
DH 791	F 27 d	1.2	2	185	25					
DH 792	F 27 d	1.8	2.1	180	25					
DH 793	F 27 d	2.7	2.2	165	25				-55 + 150	-65 + 200
DH 794	F 27 d	3.9	2.3	130	25					
DH 795	F 27 d	4.7	2.35	120	25					

diodes de contrôle control diodes

varicaps hyperabrupts au silicium silicon hyperabrupt tuning diodes

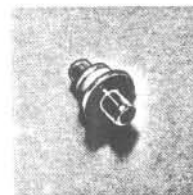
CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = V_N$ $f = 1 \text{ MHz}$		$V_1 = 2 \text{ V}$ $V_2 = 20 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$V_R = V_N$ $f = 50 \text{ MHz}$		$I_R = 10 \mu\text{A}$		CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	V_N	C_T		C_{T1}/C_{T2}	Q	γ		V_{BR}	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	V typ	pF min	pF max	pF min	min	pF min	pF max	V min	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 724	DO 7	4	12	17	5	100	1	2	25		
DH 726	DO 7	6	10	15	5	100	1	2	25		
DH 728	DO 7	8	9	14	5	150	1	2	25	- 55 + 100	- 65 + 150
DH 730	DO 7	10	7	12	5	250	1	2	25		
DH 732	DO 7	12	7	12	5	250	1	2	25		
$f = 1 \text{ GHz}$											
DH 733	F 27 d	6	0.8		5	180	1		20		
DH 734	F 27 d	6	1.2		5	160	1		20		
DH 735	F 27 d	6	1.8		5	150	1		20		
DH 736	F 27 d	6	2.7		6	100	1		20	- 55 + 150	- 65 + 200
DH 737	F 27 d	6	3.9		6	85	1		20		
DH 738	F 27 d	6	4.7		6	70	1		20		

varicaps à l'arséniure de gallium gallium arsenide tuning diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$V_1 = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$V_R = 4 \text{ V}$ $f = 1 \text{ GHz}$		$I_R = 10 \mu\text{A}$		CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	$C_T \pm 20\%$		C_{T1}/C_{T2}	Q	V_{BR}		TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE		pF typ	pF min	typ	V min					
$V_{R2} = 30 \text{ V}$											
AH 152	F 27 d		0.7		2.25	475	30				
AH 153	F 27 d		1		2.6	425	30				
AH 154	F 27 d		1.4		3	400	30				
AH 155	F 27 d		2.2		3.4	350	30		- 40 + 70	- 65 + 175	
AH 156	F 27 d		3		3.7	300	30				
$V_{R2} = 40 \text{ V}$											
AH 160	F 27 d		0.7		2.35	450	45				
AH 161	F 54		1		2.7	375	45				
AH 162	M 208 b		1.4		3.1	350	45		- 40 + 70	- 65 + 175	
AH 163	W 2		2.2		3.7	300	45				
AH 164	W 2		3		4	250	45				
$V_{R2} = 55 \text{ V}$											
AH 165	W 2		0.7		2.45	350	60				
AH 166	W 2		1		2.9	325	60				
AH 167	W 2		1.4		3.4	300	60		- 40 + 70	- 65 + 175	
AH 168	W 2		2.2		4	250	60				
AH 169	W 2		3		4.3	200	60				

varicaps abrupts au silicium, en microéléments silicon abrupt tuning diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = 4 \text{ V}$ $f = 1 \text{ GHz}$		$V_2 = V_{BR} \text{ min}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$V_1 = 2 \text{ V}$ $V_R = 4 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		$I_R = 10 \mu\text{A}$		CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	$C_T \pm 20\%$		C_{T1}/C_{T2}	Q	V_{BR}		TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION		pF typ	pF min	min	V min					
EH 740	C2		0.6		3.5	140	40				
EH 741	C2		1		3.8	135	40				
EH 742	C2		1.6		4.1	130	40				
EH 790	C2		0.6		3	195	25		- 55 + 150	- 65 + 200	
EH 791	C2		1		3.3	185	25				
EH 792	C2		1.6		3.6	180	25				



varicaps hyperabrupts au silicium en microéléments silicon hyperabrupt tuning diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_R = V_N$ $f = 1 \text{ MHz}$	$V_1 = 2 \text{ V}$ $V_2 = 20 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$V_R = V_N$ $f = 1 \text{ GHz}$	$I_R = 10 \mu\text{A}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	$V_N (\pm 1 \text{ V})$	$C_T \pm 20\%$	C_{T1}/C_{T2}	Q	V_{BR}	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	V typ	pF typ	min	min	min	V min	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 733	C2	6	0.6	5	180	20		- 55 + 150	- 65 + 200
EH 734	C2	6	1	5	160	20			
EH 735	C2	6	1.6	5	150	20			

diodes schottky de commutation switching schottky diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_M = 3 V_D$ $f = 100 \text{ MHz}$	$I_R = 10 \mu\text{A}$	$V_R = -5 \text{ V}$	$V_R = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$I_F = 1 \text{ mA}$	$I_F = 50 \text{ mA}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	t_L	V_{BR}	I_R	C_T	V_F	V_F	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	ps max	V min	nA typ	nA max	pF max	V max	V max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 501	A 22 e	60	10	10	50	1	0.5	1	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 502	A 22 e	60	15	2	20	1	0.5	1		
DH 511	A 22 e	80	15	90	250	1	0.5	1		
DH 512	A 22 e	80	20	70	200	1	0.5	1		
DH 513	A 22 e	80	25	50	150	1	0.5	1		
DH 514	A 22 e	80	30	30	100	1	0.5	1		

diodes schottky de commutation, en microéléments switching schottky diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$V_M = 3 V_D$ $f = 100 \text{ MHz}$	$I_R = 10 \mu\text{A}$	$V_R = -5 \text{ V}$	$V_R = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	t_L	V_{BR}	I_R	C_j	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ps max	V min	nA typ	pF max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 511	C2	80	15	90	0.9	- 55 + 150	- 65 + 175
EH 512	C2	80	20	70	0.9		
EH 513	C2	80	25	50	0.9		
EH 514	C2	80	30	30	0.9		

varactors limiteurs limiter varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		$I_R = 10 \mu\text{A}$	$V_R = 6 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$V_R = 6 \text{ V}$ $f = 2.75 \text{ GHz}$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS						
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25^\circ\text{C}$	V_{BR}	C_j	f_c	R_{th}	$P_{diss.}$	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C			
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	FREQUENCE MAX MAX FREQUENCY GHz	V min	V max	pF min	pF max	GHz min	°C/W max	W max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 601	F 27 d	6	30	45	0.2	0.5	150	90	0.75	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 602	F 27 d	6	30	45	0.2	0.5	200	90	0.75		
DH 603	F 27 d	8	60	90	0.2	0.5	80	70	1		
DH 604	F 27 d	8	60	90	0.2	0.5	150	70	1		
DH 605	F 27 d	10	90	120	0.2	0.5	100	50	1.5		
DH 606	F 27 d	12	120	150	0.2	0.5	100	40	2		

diodes de contrôle control diodes

varactors limiteurs rapides fast limiter varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			$I_R = 10 \mu A$	$V_R = 0 V$ $f = 1 MHz$	$V_R = 0 V$ $f = 2.75 GHz$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS				
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 ^\circ C$	V_{BR}	C_j	f_c	R_{th}	$P_{diss.}$	TEMPÉRATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$		
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	FRÉQUENCE MAX MAX FREQUENCY GHz	V min	pF min	pF max	GHz min	$^\circ C/W$ max	W max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 622	F 27 d	2-6	25	0.2	0.3	85	90	0.75		
DH 623	F 27 d	2-12	25	0.2	0.3	100	90	0.75	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 624	F 27 d	12	25	0.2	0.3	140	90	0.75		
DH 625	F 27 d	16	25	0.2	0.3	180	150	0.5		

varactors limiteurs en microéléments limiter varactors, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS			$I_R = 10 \mu A$	$V_R = 0 V$ $f = 1 MHz$	$V_R = 0 V$ $f = 2.75 GHz$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS			
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 ^\circ C$	V_{BR}	C_j	f_c	TEMPÉRATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$		FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	V min	pF min	pF max	GHz min				
EH 624	C2	25	0.2	0.3	140			- 55 + 150	- 65 + 175
EH 625	C2	25	0.1	0.2	180				

varactors de commutation switching varactors

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		10 mA - 6 mA	+ 10 mA - 10 V	$I_R = 10 \mu A$	$V_R = 6 V$ $f = 1 MHz$	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS				
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		$T = 25 ^\circ C$	t_L	t_{50}	V_{BR}	C_j	TEMPÉRATURES $^\circ C$ TEMPERATURES $^\circ C$		FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	ns typ	ps typ	V min	pF min	pF max				
EH 255	C2	40	120	40	0.8	1.4				
EH 256	C2	20	90	30	0.5	0.8			- 65 + 175	- 65 + 200
EH 257	C2	15	80	25	0.3	0.5				
EH 258	C2	10	70	20	0.15	0.3				

diodes de réception receiving diodes



diodes cristaux mélangeurs mixer diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		PREAMPLIFICATEUR I.F. AMPLIFIER		RÉSISTANCE DE CHARGE CONT. D.C. LOAD RESISTANCE		CHARGE MOYEN. FRÉQ. I.F. LOAD RESISTANCE		3 ns	
		NF = 1.5 dB		100 Ω		400 Ω			
		FRÉQUENCE INT. I.F. FREQUENCY		30 MHz					
		PUISSANCE O.L. L.O. POWER		1 mW					
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	N.F ₀	ROS VSWR	Z _{if}	FRÉQUENCE DE MESURES TEST FREQUENCY	ESSAI DE SURCHARGE TEST PULSE ENERGY		
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	FREQUENCE FREQUENCY GHz	dB max	max	Ω min	Ω max	GHz	Erg	
1N 21 C	P 3	2 - 6	8.3				3.06	2	
1N 21 CR	P 3	2 - 6	8.3				3.06	2	
1N 21 DR	P 3a	2 - 6	8.3				3.06	2	
1N 416 C	P 3	2 - 6	7.3	1.5	325	475	3.06	2	
1N 21 D	P 3	2 - 6	7.3	1.5	325	475	3.06	2	
1N 416 D	P 3a	2 - 6	7.3	1.5	325	475	3.06	2	
1N 23 C	P 3	6 - 12	9.5	1.5	325	475	0.375	1	
1N 23 CR	P 3	6 - 12	9.5	1.5	325	475	0.375	1	
1N 415 C	P 3a	6 - 12	9.5	1.5	325	475	0.375	1	
1N 149	P 3	6 - 12	8.3	1.5	325	475	9.375	1	
1N 149 B	P 3	6 - 12	8.3	1.5	325	475	9.375	1	
1N 23 D	P 3	6 - 12	8.2	1.3	350	450	9.375	1	
1N 23 DR	P 3	6 - 12	8.2	1.3	350	450	9.375	1	
1N 415 D	P 3	6 - 12	8.2	1.3	350	450	9.375	1	
1N 23 E	P 3	6 - 12	7.5	1.3	335	465	9.375	1	
1N 23 ER	P 3	6 - 12	7.5	1.3	335	465	9.375	1	
1N 415 E	P 3	6 - 12	7.5	1.3	335	465	9.375	1	
TH 8021 C	P 3c	2 - 6	8.3	2	200	800	3.06	2	
TH 8121 C	P 3c	2 - 6	8.3	2	200	800	3.06	2	
TH 8021 D	P 3c	2 - 6	7.3	1.5	325	475	3.06	2	
TH 8121 D	P 3c	2 - 6	7.3	1.5	325	475	3.06	2	
TH 8023 C	P 3c	6 - 12	9.5	1.5	200	500	9.375	1	
TH 8123 C	P 3c	6 - 12	9.5	1.5	200	500	9.375	1	
TH 8049	P 3c	6 - 12	8.3	1.5	325	475	9.375	1	
TH 8149	P 3c	6 - 12	8.3	1.5	325	475	9.375	1	
TH 8249	P 3c	6 - 12	8.3	1.5	325	475	9.375	1	
TH 8023 D	P 3c	6 - 12	8.2	1.3	350	450	9.375	1	
TH 8123 D	P 3c	6 - 12	8.2	1.3	350	450	9.375	1	
TH 8023 E	P 3c	6 - 12	7.5	1.3	335	465	9.375	1	
TH 8123 E	P 3c	6 - 12	7.5	1.3	335	465	9.375	1	

diodes cristaux détecteurs detector diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		BANDE VIDÉO VIDEO BANDWIDTH : 1 MHz		POLAR. NULLE ZERO BIAS		V _F = 5 mV		R _A = 1200 Ω P.L.O = 5 μW	
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	T _{SS}	R _V	M	FRÉQUENCE DE MESURE TEST FREQUENCY			
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	FREQUENCE FREQUENCY GHz	typ dBm	kΩ min	kΩ max	min	GHz		
1N 32	P 3	2 - 6	- 54	5	25	100	3.06		
1N 32 R	P 3	2 - 6	- 54	5	25	100	3.06		
1N 2102	P 3a	2 - 6	- 54	5	25	100	3.06		
1N 31	P 3	6 - 12	- 47	5	25	100	9.375		
1N 31 R	P 3	6 - 12	- 47	5	25	100	9.375		
TH 8032	P 3c	2 - 6	- 54	5	25	100	3.06		
TH 8132	P 3c	2 - 6	- 54	5	25	100	3.06		
TH 8031	P 3c	6 - 12	- 47	5	25	55	9.375		
TH 8131	P 3c	6 - 12	- 47	5	25	55	9.375		
TH 8231	P 3a	6 - 12	- 47	5	25	55	9.375		

diodes de réception receiving diodes

diodes schottky mélangeuses mixer schottky diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS	N.F. PRÉAMPLIFICATEUR N.F. I.F. AMPLIFIER : 1.5 dB	CHARGE MOYENNE FRÉQUENCE I.F. LOAD RESISTANCE : 400 Ω	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS
	FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE I.F. FREQUENCY : 30 MHz	RÉSISTANCE DE CHARGE CONT. D.C. LOAD RESISTANCE : 100 Ω	
	PUISSANCE O.L. L.O. POWER : 1 mW	TUBE DE BRUIT NOISE TUBE : 15.6 dB	
		3 ns	

CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	N.F ₀	R.O.S V.S.W.R		Z _{if}		FRÉQUENCE DE MESURE TEST FREQUENCY	ESSAI DE SURCHARGE TEST PULSE ENERGY	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	BANDE DE FRÉQUENCE FREQUENCY RANGE GHz	dB max	typ	max	Ω min	Ω max	GHz	Erg	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 309 D	P 3a	2 - 6	7.5	1.5	2	300	500	3.06	5	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 309 E	P 3a	2 - 6	7	1.5	2	300	500	3.06	5		
DH 309 F	P 3a	2 - 6	6	1.5	2	300	500	3.06	5		
DH 309 G	P 3a	2 - 6	5.5	1.5	2	300	500	3.06	5	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 319 D	P 3a	6 - 12	8	1.5	2	300	500	9.375	5		
DH 319 E	P 3a	6 - 12	7.5	1.5	2	300	500	9.375	5		
DH 319 F	P 3a	6 - 12	7	1.5	2	300	500	9.375	5		
DH 319 G	P 3a	6 - 12	6.5	1.5	2	300	500	9.375	5		
DH 319 H	P 3a	6 - 12	6	1.5	2	300	500	9.375	5		

diodes schottky mélangeuses schottky mixer diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS	N.F. PRÉAMPLIFICATEUR N.F. I.F. AMPLIFIER : 1.5 dB	RÉSISTANCE DE CHARGE CONT. D.C. LOAD RESISTANCE : 10 Ω	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS
	FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE : 30 MHz I.F. FREQUENCY	TUBE DE BRUIT NOISE TUBE : 15.6 dB	
	PUISSANCE O.L. L.O. POWER : 1 mW	3 ns	

CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	N.F ₀	R.O.S V.S.W.R		Z _{if}		FRÉQUENCE DE MESURE TEST FREQUENCY	ESSAI DE SURCHARGE TEST PULSE ENERGY	P _{rfmax}	I _F	V _R	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C	
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	FRÉQUENCE FREQUENCY GHz	dB max	typ	max	Ω min	Ω max	GHz	Erg	mA max	mA max	V	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
à seuil moyen - medium barrier														
DH 301	F 51	1 - 6	6.5	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 302	F 51	1 - 6	6	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3		
DH 303	F 51	1 - 6	5.5	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3		
DH 312	F 51	6 - 12	7	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 313	F 51	6 - 12	6.5	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 314	F 51	6 - 12	6	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 315	F 51	6 - 12	5.5	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 322	F 51	12 - 18	7.5	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		
DH 323	F 51	12 - 18	7	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3	- 55 + 150	- 65 + 175
DH 324	F 51	12 - 18	6.5	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		
DH 325	F 51	12 - 18	6	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		

à fort seuil - high barrier

DH 351	F 51	1 - 6	6.5	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3	- 55 + 100	- 65 + 125
DH 352	F 51	1 - 6	6.5	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3		
DH 353	F 51	1 - 6	5.5	1.5	2	200	400	3.06	5	250	50	3		
DH 362	F 51	6 - 12	7	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3	- 55 + 100	- 65 + 125
DH 363	F 51	6 - 12	6.5	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 364	F 51	6 - 12	6	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 365	F 51	6 - 12	5.5	1.5	2	200	400	9.375	5	250	50	3		
DH 372	F 51	12 - 18	7.5	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		
DH 373	F 51	12 - 18	7	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3	- 55 + 100	- 65 + 125
DH 374	F 51	12 - 18	6.5	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		
DH 375	F 51	12 - 18	6	1.5	2	200	400	15	5	250	50	3		



diodes schottky mélangeuses à faible bruit au Ga As Ga AS low noise schottky mixer diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS	N.F. PRÉAMPLIFICATEUR N.F. I. F. AMPLIFIER : 1,5 dB FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE I.F. FREQUENCY : 30 MHz PUISSANCE O.L. L.O. POWER : 1 mW RÉSISTANCE DE CHARGE CONT. D.C. LOAD RESISTANCE : 10 Ω TUBE DE BRUIT NOISE TUBE : 15,6 dB	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS
--	---	---

CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	N.F ₀	R.O.S. V.S.W.R.	Z _{if}	FRÉQUENCE DE MESURE TEST FREQUENCY	I _F	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C		
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	BANDE DE FRÉQUENCE RANGE GHz	dB max	typ	Ω min	Ω max	GHz	mA max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 378	F 51	8 - 12	5,5	2	200	500	9,375	30		
DH 379	F 51	12 - 18	5,5	2	200	500	14,3	30		
DH 383	M 208b	18 - 40	7	3	200	500	25,5	30	- 40 + 70	- 65 + 150
DH 384	BH 4	18 - 40	6,5	3	200	500	25,5	30		
DH 385	BH 4	18 - 40	6	3	200	500	25,5	30		

diodes schottky mélangeuses en microéléments mixer schottky diodes, microcomponents

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		V = 0 V f = 1 MHz		I _F = 10 mA	P _{L0} = 1 mW I _F = 30 MHz	CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS		
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	C _i	V _F	N.F ₀	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C		
TYPE TYPE	PRÉSENTATION PRESENTATION	FRÉQUENCE FREQUENCY	pF min	pF max	V typ	dB max	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
EH 305	C1	1 - 4	0,3	0,35	0,4	5,5		
EH 315	C1	4 - 8	0,17	0,22	0,42	5,5		
EH 317	C1	6 - 12	0,13	0,18	0,43	6	- 55 + 150	- 65 + 175
EH 318	C1	8 - 15	0,12	0,14	0,45	6		
EH 320	C1	12 - 18	0,07	0,10	0,47	6,5		

diodes schottky détectrices detector schottky diodes

CONDITIONS DE MESURES TEST CONDITIONS		BANDE VIDÉO VIDEO BANDWIDTH : 1 MHz COURANT DE POLAR. BIAS CURRENT : 30 μA		CONDITIONS LIMITES LIMITING CONDITIONS						
CARACTÉRISTIQUES A SPECIFICATIONS AT		T = 25 °C	T _{ss}	R _v	P _{rfmax}	I _F	V _R	TEMPÉRATURES °C TEMPERATURES °C		
TYPE TYPE	BOÎTIER CASE	BANDE DE FRÉQUENCE RANGE GHz	dBm typ	Ω min	Ω max	mW max	mA max	V	FONCTION. OPERATING	STOCKAGE STORAGE
DH 340	F 51	2 - 12	- 54	1	2	250	50	3		
DH 340	F 51	12 - 18	- 51	1	2	250	50	3	- 55 + 150	- 65 + 150
DH 309	P 3a	2 - 8	- 55	1	2	250	50	3		
DH 319	P 3a	6 - 12	- 52	1	2	250	50	3		